

Номер реєстрації, який є номером свідоцтва	6
Дата реєстрації	25.10.2007
Номер заявки	t 2007 00001
Дата подання заявки	12.06.2007
Дата першого використання топографії ІМС	30.06.2005
Дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом	25.10.2007
Дата публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС та номер бюлетеня	25.10.2007, Бюл. № 17
Заявник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал"
Автор(и)	Ткаченко Володимир Олександрович, UA, Філь Віталій Ілларіонович, UA, Сапон Сергій Васильович, UA, Шельпук Георгій Данилович, UA
Власник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал", Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103
Назва топографії ІМС	ПРЕЦИЗІЙНЕ РЕГУЛЬОВАНЕ ШУНТОВАНЕ ДЖЕРЕЛО ОПОРНОЇ НАПРУГИ AZ431-Cr (IL431, TL432)
Ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи	Вдовенко Надія Василівна
Адреса для листування	ТОВ "НВО "Кристал", п/с 22, м. Київ, 04078

Реферат:

Назва ІМС - Прецизійне регульоване шунтоване джерело опорної напруги AZ431-Cr (IL431, TL432).

Найменування заявника - Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал".

Галузь застосування - контрольно вимірвальні прилади, пристрої зарядки акумуляторів мобільної електронної апаратури, блоки живлення радіоелектронної апаратури.

Призначення - джерело опорної напруги. Забезпечує опорну напругу в діапазоні від 2,5 В до 36 В з похибкою менше 0,4 % при вихідному струмі до 100 мА і вхідній напрузі до 42 В.

Вид технології - технологія виготовлення ІМС з біполярними транзисторами, іонізованими резисторами, МОН-конденсаторами, з ізоляцією елементів р-п-переходом.

Ознакою топографії є оригінальність конструкції елементів схеми електричної ІМС і оригінальність розташування елементів на кристалі ІМС. Оригінальність конструкції елементів і їх розташування на кристалі ІМС забезпечують необхідні електричні параметри ІМС при більшій щільності упаковки кристала, тобто дозволяють збільшити число елементів схеми, що розміщуються на одиниці площі кристала. Кінцевим результатом такого підходу є зменшення габаритів кристала. Економічний ефект полягає в збільшенні знімання придатних кристалів з однієї пластинки при незмінних затратах робочого часу, енергоресурсів і витратних матеріалів. Все це приводить до зниження собівартості кристала.

Основні технічні характеристики кристала:

- діапазон опорних напруг - від 2,5 В до 36 В регульована;
- похибка опорної напруги - менше 0,4 %;
- максимальний вихідний струм - 100 мА;
- струм живлення в виключеному стані - менше 1,0 мкА.